



#3
Priority
2874 K. Jones
10-3-01

35.G2856

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RECEIVED
SEP -4 2001
TO 2800 MAIL ROOM

In re Application of:)	Examiner: Unassigned
TOSHIHIKO OUCHI ET AL.)	Group Art Unit: Unassigned
Application No.: 09/903,709)	
Filed: July 13, 2001)	
For: SURFACE OPTICAL DEVICE)	
APPARATUS, METHOD OF)	
FABRICATING THE SAME)	
AND APPARATUS USING THE)	
SAME)	August 30, 2001

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

CLAIM TO PRIORITY

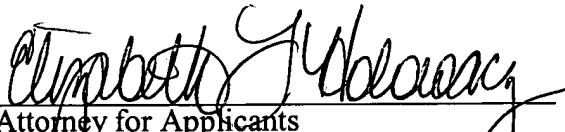
Sir:

Applicants hereby claim priority under the International Convention and all rights to which they are entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following Japanese Priority Applications: JP 2000-218163, filed on July 19, 2000 and JP 2001-12593, filed on January 22, 2001.

Certified copies of the priority documents are enclosed.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,


Attorney for Applicants
Registration No. 42,667

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

EFH:meg

NY_MAIN 196494 v 1

CFG 2856 US

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 1月22日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-012593

出 願 人

Applicant(s):

キヤノン株式会社

IC 2800 MAIL ROOM

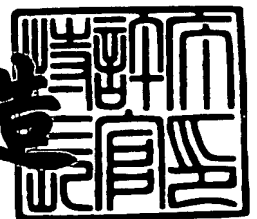
SEP - 4 2001

RECEIVED

2001年 8月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3071461

【書類名】 特許願

【整理番号】 4263011

【提出日】 平成13年 1月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B02B 6/42
H01L 27/00
H01L 31/00

【発明の名称】 面型光素子、面型光素子実装体、その作製方法、および
それを用いた光配線装置

【請求項の数】 33

【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会
社内
【氏名】 坂田 肇

【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会
社内
【氏名】 今田 彩

【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会
社内
【氏名】 尾内 敏彦

【特許出願人】
【識別番号】 000001007
【氏名又は名称】 キヤノン株式会社
【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】
【識別番号】 100086483
【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 一男

【電話番号】 0471-91-6934

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012036

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704371

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】面型光素子、面型光素子実装体、その作製方法、およびそれを用いた光配線装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】発光または受光が可能な面型光素子であって、先端がレンズ形状のポリマーを含む光ファイバを該面型光素子との光結合が可能なように差し込んで固定するためのガイド穴が、該面型光素子の表面に、光感光性あるいは電子ビーム硬化性を持ちホトリソグラフィでパターンニングすることで選択的に硬化が可能な厚膜材料で形成してあることを特徴とする面型光素子。

【請求項2】前記厚膜材料はポリマー化が可能な厚膜レジストである請求項1記載の面型光素子。

【請求項3】前記厚膜材料あるいは厚膜レジストの厚さは10 μm から1000 μm である請求項1または2記載の面型光素子。

【請求項4】前記厚膜材料あるいは厚膜レジストは、前記光ファイバのサイズより小さく光のみが透過できる穴を形成した第1層と、該第1層上に形成され該光ファイバを固定するためのガイド穴を形成した第2層から成り、第1層の厚さで前記面型光素子と該光ファイバの端面の距離を規定している請求項1、2または3記載の面型光素子。

【請求項5】前記厚膜材料あるいは厚膜レジストで形成したガイド穴は、該光ファイバの外形に合わせてある部分のみを形成している請求項1乃至4の何れかに記載の面型光素子。

【請求項6】前記厚膜材料あるいは厚膜レジストで形成したガイド穴は、該光ファイバの外形に合わせてある部分と共に、その外形とは異なる溝パターンをも形成している請求項1乃至4の何れかに記載の面型光素子。

【請求項7】前記ガイド穴の光ファイバの外形に合わせてある部分と溝パターンは連続して形成されている請求項6記載の面型光素子。

【請求項8】前記面型光素子は複数アレイ化され、それに対応してガイド穴も共にアレイ化して形成されている請求項1乃至7の何れかに記載の面型光素子。

【請求項9】前記複数の面型光素子は面型発光素子のみ、面型受光素子のみ、

あるいは面型発光素子と面型受光素子の組み合わせである請求項8記載の面型光素子。

【請求項10】 前記面型光素子は垂直共振器型の面発光レーザないし発光ダイオードである請求項1乃至9の何れかに記載の面型光素子。

【請求項11】 前記面発光レーザは、活性層、共振器層、およびブラッグ反射ミラー層のみの機能層が残されている請求項10記載の面型光素子。

【請求項12】 前記面型光素子は、成長基板を除去或いは薄膜化して薄膜型になっている請求項1乃至10の何れかに記載の面型光素子。

【請求項13】 前記面型光素子は、成長基板がそのまま残されている請求項1乃至10の何れかに記載の面型光素子。

【請求項14】 前記光ファイバの先端が凹レンズ状に加工されていて、この凹部に樹脂が充填されている請求項1乃至13の何れかに記載の面型光素子。

【請求項15】 前記樹脂は該光ファイバより高い屈折率を有する樹脂である請求項14記載の面型光素子。

【請求項16】 前記光ファイバの先端と前記面型光素子との間隙に樹脂を充填して使用する請求項1乃至13の何れかに記載の面型光素子。

【請求項17】 請求項1乃至16記載の何れかに記載の面型光素子が、実装基板に、駆動が可能なように電氣的接続を有して実装され、前記ガイド穴に光ファイバを固定して成ることを特徴とする面型光素子実装体。

【請求項18】 前記実装基板は、他の光素子あるいは電子素子をハイブリッドに集積することができ、ヒートシンク機能を持つ実装基板である請求項17記載の面型光素子実装体。

【請求項19】 前記面型光素子が複数アレイ化され、光ファイバも同時にアレイ化してなる請求項17または18記載の面型光素子実装体。

【請求項20】 前記光ファイバの先端と前記面型光素子との間隙に樹脂が充填されている請求項17、18または19記載の面型光素子実装体。

【請求項21】 前記樹脂は硬化性樹脂である請求項20記載の面型光素子実装体。

【請求項22】 前記硬化性樹脂は、光学接着剤ないし透明樹脂である請求項21記載の面型光素子実装体。

【請求項23】前記光ファイバの先端が凹レンズ状に加工されていて、且つ、前記樹脂は該光ファイバより高い屈折率を有する樹脂である請求項20記載の面型光素子実装体。

【請求項24】前記光ファイバの先端が凸レンズ状に加工されていて、且つ、前記樹脂は該光ファイバより低い屈折率を有する樹脂である請求項20記載の面型光素子実装体。

【請求項25】前記光ファイバの先端と前記面型光素子との間隙に空気或いは窒素ガスが充填されている請求項17、18または19記載の面型光素子実装体。

【請求項26】前記光ファイバの先端が凸レンズ状に加工されている請求項25記載の面型光素子実装体。

【請求項27】前記光ファイバの先端は、凹レンズ状ないし凸レンズ状の加熱された鋳型に該光ファイバの先端を押し付けすることで加工されてなる請求項17乃至26の何れかに記載の面型光素子実装体。

【請求項28】前記光ファイバの先端は、有機溶剤中に該光ファイバの先端を浸漬し、引き上げた後乾燥させることで加工されてなる請求項17乃至26の何れかに記載の面型光素子実装体。

【請求項29】前記光ファイバは全フッ素化ポリマーを含む光ファイバで構成される請求項17乃至28の何れかに記載の面型光素子実装体。

【請求項30】前記光ファイバはポリメチルメタアクリレートを含む光ファイバで構成される請求項17乃至28の何れかに記載の面型光素子実装体。

【請求項31】請求項17乃至30の何れかに記載の面型光素子実装体を作製する方法において、ウエハ状の実装基板に配線パターンを形成する工程、少なくとも1つの面型光素子を逐次、実装基板の複数箇所に、実装する工程、各面型光素子上に厚膜材料でガイド穴を形成する工程、必要な電子デバイス等のデバイスを必要な位置に逐次フリップチップ実装した後に必要な大きさの実装体に複数切り出す工程、最後に先端がレンズ形状の光ファイバをガイド穴に差し込んで固定する工程を含むことを特徴とする面型光素子実装体の作製方法。

【請求項32】電子機器内のボードに接続リードを介して実装して、ボード間の信号の授受を光で行う光配線装置において、請求項17乃至30の何れかに記載の面

型光素子実装体に面型光素子駆動用電子回路も集積化しており、電氣的接触を得るための接続リードを固定する台座に該光素子実装体を実装して光接続モジュールを構成していることを特徴とする光配線装置。

【請求項33】 請求項17乃至30の何れかに記載の面型光素子実装体を面型光素子駆動用電子回路上に実装して電気コネクタ内に収めて、該駆動用電子回路への電気接続を脱着可能なコネクタ用の接続ピンで行い、電子機器同志の信号の授受を光で行うことを特徴とする光配線装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光ファイバを効率良く光学的に結合できる面型光素子、面型光素子と光ファイバを低コストで光学的に結合した光実装体（これらの面型光素子、光実装体を本明細書では光インタコネクションモジュールなどとも言う）、その作製方法、およびそれを用いた光配線装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、高速光接続のための光モジュールが開発されている。しかし、光素子と光ファイバなどの光伝送体との結合に関しては、特に、低コスト化、高性能化などの観点から課題が多い。

【0003】

光素子として、受光素子では、作製の容易性や感度などの点で面型の素子が主に使用されているが、光ファイバと該面型素子の主面とで光結合させる場合に、受光素子を動作させないでアライメントするパッシブアライメントが低コスト化のためには必須である。そのための手法として、一般には固定部材を作製して組み立てるという方法が用いられている。しかし、固定部材の機械精度が要求され、その弾性係数や熱膨張係数などに制約があり、また部品点数も多くなるために、コスト低減が困難であった。特に、コスト低減のためにプラスチックモールドなどを用いると、光結合の歩留まりや長期信頼性に欠けるという問題点がある。

【0004】

発光素子においても、基板面から垂直に光出射を行う垂直共振器型面発光レーザが、光伝送モジュールの低消費電力化、低コスト化の観点で改善できる可能性があり、盛んに研究されている。該面発光レーザでは、1mA以下の低しきい値で駆動でき、ウエハレベルの検査が可能で、へき開精度を必要としないため、低コスト化が可能である。このような面発光レーザと光ファイバとの光結合においても上記と同様な問題が生じている。

【0005】

そこで、光ファイバとの結合のためのガイド穴をホトリソグラフィの精度で作製する方法が提案されている。例えば特開平8-111559号公報では、図12に示すように、面型受光素子もしくは発光素子を作製した基板1021側に光ファイバ1037を固定するための穴をエッチングにより形成するものが開示されている。尚、図12において、1022は光吸収層、1023と1027はDBRミラー、1024と1026はクラッド層、1025は活性層、1028はコンタクト層、1032はSiO₂層、1033と1035は電極、1036は反射防止膜である。

【0006】

また、特開平6-237016号公報にも、図13に示すように、面発光レーザ1203の裏面側に、基板をエッチングしたガイド穴1209を形成して光ファイバ1210を固定する方法が開示されている。これらの場合、部品点数を減少させることができ、組み立ても非常に簡単なので、低コスト化が可能である。尚、図13において、1201は電子回路基板、1202は発光チップ、1204はトランジスタ、1205と1206と1207はトランジスタ電極、1208は絶縁層、1211は接着剤である。

【0007】

しかしながら、基板に穴を開ける方法では、光ファイバと受光部あるいは発光部との距離の制御が難しく、ファイバを結晶に突き当てたときに結晶にダメージが入るために素子を劣化させてしまう恐れがあった。そこで、特開平6-237016号公報の発明では、ガイド穴1209に順テーパ形状をつけてファイバが結晶面と接触しない様にガイド穴先端の径を小さくしたり(図13参照)、完全にエピ層までエッチングせずに基板をわずかに残した状態でエッチングを止めるなどの方法が用いられていた。

【0008】

一方、面型光素子が形成された表面側にファイバ固定用の部材を直接固定して、光ファイバを実装する方法も提案されている。例えば、特開平11-307869号公報においては、図14に示すように、面発光レーザ素子2018の表面にファイバ固定部材2014を嵌合させるための突起2022、2023を設け、面発光レーザ2018の発光部に対応する位置にガイド穴を構成したものが開示されている。尚、図14において、2012はモジュール基板、2016は光ファイバ、2024はファイバ挿入孔、2026と2027はガイド孔である。

【0009】

【発明が解決しようとしている課題】

しかしながら、エッチングでガイド穴を作製する場合、その深さは通常100 μm 以上になるため、テーパ形状や穴径の制御性には問題があり、歩留まりを向上させることは困難であった。また、基板を残す場合には基板での光の吸収の問題があって、使用できる波長帯には制限があった。

【0010】

一方、光ファイバ固定用ブロックを用いる場合では、上記のような作製上の問題は生じないが、部品点数とその加工工程が増えてしまうために、必ずしも低コスト化ができなかった。

【0011】

さらには、光ファイバからの出射光は広がるため、できるだけ受光素子と近づけて実装することが肝要であったが、それでも、受光素子への入射効率を高くすることは困難であった。同様に、発光素子との接続についても、発光素子の発光径および放射角と光ファイバのコア径および受容角との不整合が大きければ、光ファイバへの光結合効率を高くすることは困難であった。

【0012】

このような課題に鑑み、本発明の目的は、光ファイバを固定するガイド穴を形成して、部品点数の増加やプロセス制御性の向上を必要とせずに、光導波体と面型光素子のアライメント精度を向上させ、このことから、光ファイバの固定作業も容易にして生産性を向上させ、低コスト化を図り、更に、面型光素子と光ファ

ファイバの間の距離を自由に設定でき、実装の容易性、自由度を向上させる構造を提供することにある。さらに、このような実装するための構造体を量産できる作製方法、低コスト化が可能な光実装体、およびこれを用いた光配線装置を提供することにある。

【0013】

特に、本発明の目的は、光ファイバの先端をレンズ形状に加工することで、発光または受光素子との光結合効率を向上させ、このことから、光インタコネクションモジュールの挿入損失を低減し、素子駆動に関わる消費電力の低減化を図り、生産性を向上させ低コスト化を図る構造を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段および作用】

本発明の面型光素子においては、面型光素子の表面に厚膜材料により直接ホトリソグラフィによって、光ファイバを差し込むためのガイド穴となる構造体を作り込むことで、上記課題を解決するものである。すなわち、本発明の発光または受光が可能な面型光素子は、先端がレンズ形状のポリマーを含む光ファイバを該面型光素子との光結合が可能なように差し込んで固定するためのガイド穴を、該面型光素子の表面に、光感光性あるいは電子ビーム硬化性を持ちホトリソグラフィでパターンニングすることで選択的に硬化が可能な厚膜材料(ポリマー化が可能な厚膜レジストなど)で形成してあることを特徴とする。

【0015】

前記厚膜材料ないし厚膜レジストの厚さとしては、 $10\mu\text{m}$ (これは石英シングルモードファイバのコア程度である)～ $1000\mu\text{m}$ (これはアクリル材料によるプラスチックファイバ(POF)のコア程度である)がよく、さらに好ましくは $50\mu\text{m}$ から $500\mu\text{m}$ 程度のものが好適に用いられる。光ファイバのサイズとして、 $125\mu\text{m}$ 程度から 1mm 程度までどのようなサイズでも適用可能である。光ファイバの芯線径で言えば、 $100\mu\text{m}$ から 1mm 程度まで、どのようなサイズでも適用可能である。厚膜材料ないし厚膜レジストは通常のホトリソグラフィ工程でプロセスを行うため、面型光素子とガイド穴中心位置を精度良く合わせることが簡単にできる。そのため、ガイド穴を形成した構造体をアライメントして接着する工程などを省くことが

できる。

【0016】

穴径の制御性や形状制御も厚膜材料ないし厚膜レジストの特性から優れており、基板エッチングにより穴を開ける方法に比べて工程が簡単になる。

【0017】

面型光素子については、面発光レーザや面型受光素子などが用いられ、実装基板に必要なチップサイズ、アレイ数の素子を実装してから成長基板を除去して薄膜型にすることで、実装基板をハンドリング基板として用いることもできる。これにより、面型光素子のエピウエハから取り得る収率が増大して低コスト化することができる。

【0018】

また、前記面型光素子は複数アレイ化され、それに対応してガイド穴も共にアレイ化して形成されたり、前記複数の面型光素子は面型発光素子のみ、面型受光素子のみ、あるいは面型発光素子と面型受光素子の組み合わせであったり、前記面型光素子は垂直共振器型の面発光レーザ或いは発光ダイオードであったり、面発光レーザは、活性層、共振器層、およびブラッグ反射ミラー層のみの機能層が残されているものであったり、前記面型光素子は、成長基板を除去或いは薄膜化して薄膜型になっていたり、成長基板がそのまま残されているものであったりする。

【0019】

光ファイバ端面と面型光素子の距離については、厚膜材料ないし厚膜レジストを2層にして、1層目の厚みで距離をコントロールするようにすれば、制御性、自由度を向上させることができる。すなわち、前記厚膜材料あるいは厚膜レジストは、前記光ファイバのサイズより小さく光のみが透過できる穴を形成した第1層と、該第1層上に形成され該光ファイバを固定するためのガイド穴を形成した第2層から成り、第1層の厚さで前記面型光素子と該光ファイバの端面の距離を規定する様にできる。

【0020】

光ファイバガイド穴の形状についてもホトマスクの設計次第で自由に設定する

ことができ、固定用接着剤の逃げを作り込んだり、光ファイバとガイド穴が嵌合しやすいように設計すること(例えば、ガイド穴をテーパ状にする)も可能である。すなわち、前記厚膜材料あるいは厚膜レジストで形成したガイド穴は、該光ファイバの外形に合わせてある部分のみを形成して成ったり、該光ファイバの外形に合わせてある部分とともに、その外形とは異なる溝パターンをも形成して成ったり、この場合、前記ガイド穴の光ファイバの外形に合わせてある部分と溝パターンは連続して形成されたりする。

【0021】

前記光ファイバについては、その先端が凹レンズ状に加工されていて、この凹部に樹脂が充填されていたりする。この樹脂は、集光効果を良くする為に、典型的には、光ファイバより高い屈折率を有する樹脂である。また、前記光ファイバの先端と前記面型光素子との間隙に樹脂を充填して使用されたりする。

【0022】

更に、本発明の面型光素子実装体は、上記の面型光素子が、実装基板に、駆動が可能のように電氣的接続を有して実装され、前記ガイド穴に光ファイバを固定して成ることを特徴とする。

【0023】

前記実装基板は、他の光素子あるいは電子素子をハイブリッドに集積することができ、ヒートシンク機能を持つ実装基板であったりする。前記面型光素子は複数アレイ化され、光ファイバも同時にアレイ化し得る。前記光ファイバは、ポリマーを含む光ファイバすなわちプラスチック光ファイバ(POF)で構成される。

【0024】

また、素子との光結合効率をより向上させる為に、光ファイバの先端をレンズ形状に加工し、光ファイバの先端と面型光素子との間隙に樹脂、空気、或いは窒素ガスを充填させてもよい。この樹脂は、光学接着剤ないし透明樹脂などである硬化性樹脂であったりする。光ファイバの先端が凹レンズ状に加工されていて、前記樹脂が該光ファイバより高い屈折率を有したり、光ファイバの先端が凸レンズ状に加工されていて、前記樹脂が該光ファイバより低い屈折率を有したりする。光ファイバの先端と面型光素子との間隙に空気或いは窒素ガスが充填されてい

る場合には、前記光ファイバの先端は典型的には凸レンズ状に加工される。

【0025】

本発明におけるプラスチック光ファイバとは、コアとクラッドからなる芯線部がポリマーである光ファイバ、ないしはクラッドもしくはコアのみがポリマーである光ファイバを指す。芯線周囲が、保護層やポリマージャケットで被覆されていてもよい。また、芯線部がステップインデックス型（屈折率段階型）光ファイバでもグレーデッドインデックス型（屈折率分布型）光ファイバでもよい。

【0026】

プラスチック光ファイバの先端の形状は、加熱した鋳型にプラスチック光ファイバの先端を押し付けることで自由に加工が可能である。あるいは、クラッドもしくはコアが溶融する適当な有機溶剤に浸漬して、浸漬時間、引き上げ方等を制御することで凸レンズ状もしくは凹レンズ状に整形する手法もある。その際、発光または受光素子と光ファイバ端面の間に空気あるいは窒素ガスなどが充填される場合は、凸面先端とする。これに対して、発光または受光素子と光ファイバ端面間に硬化性樹脂などが充填される場合は、光ファイバと該樹脂の屈折率の大小関係に鑑み、凸面あるいは凹面とする。いずれにせよ、別個のレンズを位置合わせのうえ実装することなく、光ファイバ自体が集光性を有する凸レンズ機能を発現できる。

【0027】

鋳型を用いる場合、剃刀などにより平面状に切断したプラスチック光ファイバ端面に、加熱した凸面状もしくは凹面状の鋳型を押し付けるなどの手法により、該プラスチック光ファイバ端面に凹面もしくは凸面レンズを作製する。球面ないし非球面の鋳型径は、プラスチック光ファイバのコア径と同程度かそれ以上が好ましい。凹面先端構造の場合には、プラスチック光ファイバよりも高い屈折率を有する硬化性樹脂などを充填する。凸面構造の場合は、空隙部に空気ないし窒素を充填するか、プラスチック光ファイバよりも低い屈折率を有する硬化性樹脂などを充填する。硬化性樹脂としては、透明性が優れ、硬化時の発泡や収縮膨張の少ない合成樹脂性接着剤あるいは透明樹脂などを用いることが好ましい。熱硬化性の合成樹脂性接着剤においては、プラスチック光ファイバの軟化が起こらない

低温硬化性接着剤が好ましく、全フッ素化ポリマー系プラスチック光ファイバおよびポリスチレン系プラスチック光ファイバでは70℃以下、ポリメチルメタアクリレート系プラスチック光ファイバでは80℃以下、ポリカーボネート系プラスチック光ファイバでは125℃以下が好ましい。

【0028】

全フッ素化ポリマー系プラスチック光ファイバのように、屈折率が1.3～1.4程度に低い光ファイバでは、硬化性樹脂で充填して凸レンズ効果を得ようとする、さらに低屈折率の硬化性樹脂を選択する必要がある。しかしながら、そのような低い屈折率を有する硬化性樹脂は殆どなく、たとえ実現したとしても光ファイバとの屈折率差が小さいため、屈折パワーの極めて弱い凸レンズしか実現しない。そこで、本発明では、プラスチック光ファイバの端面を逆に凹面状として、その凹面構造に比較的高い屈折率の硬化性樹脂を充填させることで、硬化性樹脂側を凸レンズとして集光作用を発現させる。端面を凸状レンズとする手法に比べ、光ファイバ端面中央部がへこんでいるため、発光または受光素子と近接させても、接触することはなく、光ファイバの実装が容易になる。

【0029】

更に、本発明の上記の面型光素子実装体を作製する方法は、ウエハ状の実装基板に配線パターンを形成する工程、少なくとも1つの面型光素子を逐次、実装基板の複数箇所に、実装する工程、各面型光素子上に厚膜材料でガイド穴を形成する工程、必要な電子デバイス等を必要な位置に逐次フリップチップ実装した後に必要な大きさの実装体に複数切り出す工程、最後に光ファイバをガイド穴に差し込んで固定する工程を含むことを特徴とする。

【0030】

更に、本発明の光配線装置は、電子機器内のボードに接続リードを介して実装して、ボード間の信号の授受を光で行う光配線装置であって、上記の面型光素子実装体に面型光素子駆動用電子回路も集積化しており、電氣的接触を得るための接続リードを固定する台座に該光素子実装体を面実装して光接続モジュールを構成していることを特徴としたり、上記の面型光素子実装体を面型光素子駆動用電子回路上に実装して電気コネクタ内に収めて、該駆動用電子回路への電気接続を

、脱着可能なコネクタ用の接続ピンで行い、電子機器同志の信号の授受を光で行うことを特徴とする。

【0031】

このように、厚膜レジストないし厚膜材料を用いて面型光素子と光ファイバを結合させた光素子実装体を、電子回路と集積化させて、送受信を備えた光インターコネクション装置として用いることができる。その場合、電子回路ボード間の光配線、電子機器間の光接続などに利用でき、電磁放射ノイズを抑えながら1chあたり1Gbps以上で多チャンネルの大容量高速伝送を低コストで実現することができる。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下に、図面を用いて本発明の実施例で発明の実施の形態を説明する。

【0033】

(第1の実施例)

本発明による第1の実施例を斜視図である図1に示す。750 μ mピッチで4つにアレイ化された面発光レーザ5が、実装基板1に、共通電極2を介してボンディングされている。各素子5の素子分離溝が8で示され、発光点に相当する部分が6で示されている。面発光レーザ5を駆動するための電気配線は、共通電極用の配線10と独立駆動用の配線9が実装基板1上に形成されている。面発光レーザ駆動用の独立電極25は配線9と接続されている。また、面発光レーザ駆動用のドライバIC12が同一実装基板1上にフリップチップ実装されている。ドライバIC12は配線13により他の電子デバイス等に接続される。

【0034】

ガイド穴4に挿入する光ファイバとしては、補強層を含んだ全径500 μ mの全フッ素化ポリマー系プラスチック光ファイバ16が用いられている。POF16は、プラスチックモールドで形成されたV溝を持つ固定治具14と平坦治具15によりサンドイッチされて、接着剤17により固定されている。このV溝によって、POF16のピッチおよび中心位置の整列が行えるようになっている。POF16の先端は、固定治具14、15で形成される面よりも図1に示すように突き出た形になっており、本実施例

では突き出し量を $500\mu\text{m}$ とした。4本のプラスチック光ファイバ16は、固定治具14、15を用いて接着固定したあと剃刀などで平面状に一括切断して、加熱した凸面鋳型を押し付けて端面に球面状凹構造18を作製する。図2では、プラスチック光ファイバ径よりも小さな、しかしコア径よりは大きな径を有する球面状凹構造18を作製し、その周囲の端面に平面が残されている例を示している。

【0035】

この球面状凹構造18に、プラスチック光ファイバ16よりも高い屈折率を有する硬化性樹脂19を充填する。硬化性樹脂は1.4~1.7程度の屈折率を有し、全フッ素化ポリマー系光ファイバ（例：旭ガラス製、商品名ルキナ）は約1.35、ポリメチルメタアクリレート系光ファイバでは約1.49であり、集光効果を得るには十分な屈折率差（典型的には、0.2から0.3程度）である。硬化性樹脂19は、室温硬化タイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプとあるが、全フッ素化ポリマー系光ファイバでは、軟化する温度が比較的低いため、室温硬化タイプを使用した。無論、プラスチック光ファイバの軟化する温度より低い硬化温度を有する硬化性樹脂であれば、加熱硬化は可能である。また、光ファイバガイド穴4が紫外線透過性であれば、光硬化タイプを使用することもできる。屈折率差が適当であり、光学的に安定していれば、非硬化性の樹脂を用いることもできる。

【0036】

本実施例で用いたPOF16は、 $0.8\mu\text{m}$ 帯、 $1.3\mu\text{m}$ 帯で伝送可能な全フッ素化ポリマーを用いた光ファイバ（旭ガラス製、商品名ルキナ）としたが、ポリメチルメタアクリレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、重水素化ポリマーを用いたものや、UV硬化樹脂を用いたものなど、材料には制限はない。また、ファイバ径に応じてガイド穴4の径や固定治具14のV溝の形状を設計すればよい。

【0037】

一方、本発明の特徴となる光ファイバ用のガイド穴4は、面発光レーザ5の各発光点6の中心が光ファイバ16のコア中心と一致するように、厚膜レジスト3で形成されている。図1では分かりやすいように透視斜視図としている。この厚膜レジスト3は、実装基板1上に直接スピンコーターなどで塗布して、ホトリソグラフィを行うことでパターン形成している。パターン合わせは、面発光レーザ5の表面

に形成した電極25と合わせるマークをホトマスク上に形成しておけば、発光点6の中心とガイド穴4の中心を数 μm 以下の位置精度で一致させることができる。

【0038】

本実施例では、厚膜レジスト3としてMicroChem社のSU8-50を用いた。スピニングにより $200\mu\text{m}$ の厚さで塗布し、ホットプレート上において 90°C でプリベークを行った。 $3\text{mm}\times 1\text{mm}$ の外枠サイズで、 $750\mu\text{m}$ ピッチで $520\mu\text{m}$ の円形パターンを持つように、ホトマスクを用いて上記のようなパターン合わせを行いながら、アラインで露光を行った。次に、再びホットプレート上で 90°C で露光後ベークを行なった後、現像液によってレジストの現像を行った。現像後のリンスはイソプロピルアルコールで行い、溶剤を完全に蒸発させるためにオーブンで 90°C のベークを行った。以上のように厚膜レジスト3の工程は低温で行えるため、光素子5や電気コンタクトなどに損傷を与えることなく、ガイド穴4を形成できる、厚膜レジスト3としては、ここではSU8を用いたが、これに限定されるものではない。

【0039】

次に、硬化性樹脂19を光ファイバガイド穴4に塗布した後、固定治具に固定されたプラスチック光ファイバ16を差し込むことで、光ファイバ16の端面の凸レンズ作用が発現し、容易に光結合が達成できる。

【0040】

次に、1つの素子の断面図である図2(図4のA-A'断面)を用いて、面発光レーザ5とPOF16との結合部について説明する。

【0041】

本実施例で用いた面発光レーザ5の詳細は後に説明するが、厚膜レジスト3の工程が行い易いように成長基板を除去して、機能層のみを転写して薄膜化した構造としている。機能層は、活性層を含む1波長共振器23をAlGaAs多層膜からなるp-DBRミラー22およびn-DBRミラー24で挟んだ構造となっており、厚さは約 $7\mu\text{m}$ である。p-DBRミラー22側に電流狭窄のためのエアポスト28を $15\mu\text{m}\phi$ の円形に加工し、周りはポリイミド27で埋め込んで平坦化している。活性層近傍には、Alモル分率が0.95以上のAlGaAs層のみを横方向に選択的に水蒸気酸化して Al_xO_y 層29を形成してあり、電流注入領域のアパーチャサイズを $3\mu\text{m}\phi$ 程度にして、発振しきい

値を1mA以下にしている。

【0042】

p-DBRミラー22側に共通電極20を形成し、基板1表面の電極パッド2の上にAuSnはんだ等で接着している。接着はAu同志の圧着でもよい。n側の電極25は、各素子に独立に電流注入できるように、n-DBRミラー24表面のGaAs基板(不図示)を除去して現れた表面上に形成している。この表面に絶縁膜26を形成して、光取り出し部31およびコンタクトホール32を形成し、基板1の表面に形成する配線9とのコンタクトを取るようにしている。なお、配線9は面発光レーザ5の側壁も介して段差配線するため、レーザ5の側壁およびp側の共通電極パッド2の上が絶縁膜26で覆われている必要がある。このような絶縁膜形成には、例えば旭化成製PIMELのような感光性ポリイミドが好適に用いられ、厚さは1 μ mとした。

【0043】

プラスチック光ファイバ16は図2のように凹面先端の周囲の平面領域が、素子表面に突き当たる位置(この例では配線9)で固定される。凹面構造18が光ファイバ16の中央部に形成されているため、光ファイバ端面が面発光レーザの結晶表面に直接当たることはなく、これにダメージ等を与えることはない。

【0044】

一方、面発光レーザから発生する熱は、電極パッド2を介して実装基板1に放熱するようにしている。そのため実装基板1の材質としては、AlN、または表面にAl₂O₃などの絶縁薄膜を形成したSiが好適に用いられる。

【0045】

次に、図3を参照して本実施例に用いた薄膜型の面発光レーザの作製工程を説明する。ここでは簡単化のため2つの素子のアレイで説明する。

【0046】

(a)において、n-GaAs基板30上に、n-DBRミラー24、GaAs/AlGaAsの3量子井戸から成る活性層を含みAlGaAsから成る1波長共振器層23、P-DBRミラー22、p-GaAsコンタクト層(不図示)を有機金属気相成長法などにより結晶成長する。エアポスト28をCl₂を用いた反応性エッチングにより形成し、上述した選択酸化層29を水蒸気による酸化により形成する。その後、SiN_x膜21で絶縁膜を形成してポリイミド

27で平坦化を行い、共通電極20を成膜する。共通電極20としては例えばTi/Auを用いることができる。

【0047】

(b)において、(a)で作製したウエハ上の素子を基板30の研磨で $100\mu\text{m}$ 程度にしてから適当な大きさに切り出し、実装基板1上に形成した電極パッド2の上に、Au-Auの圧着(超音波でアシストしてもよい)で、あるいはAuSnはんだで、接着を行う。このとき電極パッド2はTi/Pt/Auから成り、最表面はAuとなっている。

【0048】

(c)において、GaAs基板30を H_2O_2 と NH_3 の混合液を用いてエッチングし、n-DBRミラー24の第1層であるAlAsでエッチングがストップされる。その後、HClによってAlAsを除去して現れたn-GaAs層上に、独立電極25を形成する。独立電極25には、例えばAuGe/Ni/Auを用いることができる。その後、コンタクトのために 380°C 程度でアニールを行う。

【0049】

(d)において、感光性ポリイミドで電極コンタクトのためのホール32および光取り出し窓31を形成しながら、全体をポリイミド26でコーティングするようにする。配線9をTi/Auなどでリフトオフ法等で形成すれば、図4の平面図のような実装基板1上に薄膜型面発光レーザ5が形成された状態となる。

【0050】

上記では、1つのチップについての作製工程について述べたが、実際には生産性の向上のためにウエハレベルの工程が必要になる。その様子を説明するものが図5である。面発光レーザが作製されたGaAsウエハ50から、必要な大きさのレーザチップ51(上記の実施例では 1×4 アレイ)を切り出し、表面に Al_2O_3 膜および電極パッド2を必要な領域54に複数形成したSiウエハ52に接着する。このとき、フリップチップボンダー装置でウエハ52上の必要な位置54にアライメントをしながら逐次ボンディングを行う。レーザの薄膜化プロセス、配線プロセスおよび厚膜レジスト3によるファイバガイド穴4の形成は、この状態で一括してホトリソグラフィおよびエッチング工程で行う。

【0051】

次に、レーザ駆動用のSi-IC53をフリップチップボンダーで逐次ボンディングする。最後に、破線55のように1つ1つのチップにダイシングすれば、一括して複数のチップが形成できる。

【0052】

なお、ここまでの例では、面発光レーザ5および光ファイバ16のアレイ数を4つとした例を示してきたが、もちろんこの数には限定はない。4つ以上でもよいし、1つの面発光レーザと1本の光ファイバのみとしたものでもよい。また、面型受光素子に適用することもできる。

【0053】

光実装体としては、送信側において面発光レーザだけが集積されたもの、受信側において面型受光素子のみが集積されたもの、あるいは送受信の両方を備えた光実装体とするもののいずれでもよい。送信デバイス、受信デバイスが分かれている場合には一方向伝送となり、他方、送・受信デバイスが1つのモジュール内に収められていれば、双方向伝送が可能となる。

【0054】

(第2の実施例)

本発明の第2の実施例は、GaAs基板を除去した薄膜型の面発光レーザではなく、GaAs基板上に作製した通常の面発光レーザを用いた例に係わる。面発光レーザの断面構造は、プロセスを説明する図の図3(a)に示されるものとほぼ同じで、p側の電極の構造が光取り出し用の窓を設けたことと、素子間で電極分離するところが異なる。

【0055】

図8に本実施例の斜視図を示す。面発光レーザ84の切り出しサイズが大きくなったこと、レーザ84とIC12の配線81をワイヤボンディングで行った以外は、図1の構成とほぼ同じであり、同一部分の説明は省略する。

【0056】

GaAs基板上に作製された面発光レーザ84の表面には、絶縁膜上にp電極兼電気配線および電極パッドとなるTi/Au82が形成されている。そのp電極の発光点83に相当するところには光取り出し窓が形成されている。IC12と電氣的に接合してい

る実装基板1上の電極パッド80とP電極82の間は、ワイヤボンディング81で配線されている。この配線はフレキシブル配線板などを用いてもよい。

【0057】

ファイバガイド穴4を構成する厚膜レジスト3は、GaAs基板上で面発光レーザおよびp電極を形成してから、チップに切り出す前に一括して表面上に形成している。従って、面発光レーザ84のチップを実装基板1上に実装したあとのホトリソグラフィ等のプロセスはなく、一括リフロー(はんだの加熱)による表面実装およびワイヤボンディングなどによる配線があるだけである。

【0058】

本実施例では、GaAsウエハからのチップ切り出しサイズが第1の実施例より大きいいため、レーザウエハから得られるレーザの個数すなわち収率が低減して実装体のコストが上昇する。また、カソードコモンとして駆動するために第1の実施例のようなアノードコモンタイプに比べて駆動の高速性に劣る。

【0059】

しかし、本実施例における構造では、プロセス工程が少なくなつて作製コストの低減および歩留まりの向上が可能となるので、アレイ数が少なく622Mbps程度の伝送の場合には適している。

【0060】

(第3の実施例)

本発明による第3の実施例を図6に示す。本発明の第3の実施例は、プラスチック光ファイバ端面を凸状に加工した例である。プラスチック光ファイバ64は、ポリメタルメタアクリレート系の光ファイバであり、その端面は、凹面状の型に加熱押し付けして、凸面先端65として整形されている。光ファイバガイド穴4に段差をつけることで、光ファイバ64の中央凸部が光素子に接触しないように工夫されている。また、硬化性樹脂として、紫外線硬化型接着剤を用いて、周囲を固めて、凸レンズ部は空気(或いは、非活性ガス、例えば窒素など)ないし接着剤で充填される構成を取っている。接着剤で充填される場合は、プラスチック光ファイバより低屈折率のものを使用する。

【0061】

また、発光素子として、GaAs基板30上に作製した発振波長650 nmの赤色発光ダイオードを用いる。構造が似ている図9（ただし、図9では面発光レーザ84を用いる）を参照しつつ、ここでの符号を借用して説明すると、GaAs基板上に作製された発光ダイオード84の表面には絶縁膜上にp電極兼電気配線および電極パッドとなるTi/Au82が形成されている。そのp電極の発光点に相当するところには光取り出し窓83が形成されている。ICと電氣的に接合している実装基板1上の電極パッド80とp電極82の間はワイヤボンディング81で配線されている。この配線はフレキシブル配線板などを用いてもよい。

【0062】

光ファイバガイド穴4を構成する感光性樹脂3は、GaAs基板上で発光ダイオードおよびp電極を形成してから、チップに切り出す前に一括して表面上に形成している。従って、発光ダイオードのチップ84を実装基板1上に実装したあとのホトリソグラフィ等のプロセスはなく、一括リフローによる表面実装およびワイヤボンディングなどによる配線があるだけである。

【0063】

本実施例では、発光ダイオードを駆動するために面発光レーザに比べて高速性に劣る。しかし、本実施例における構造では、プロセス工程が少なくなつて作製コストの低減および歩留まりの向上が可能となるので、アレイ数が少なく100から200Mbps程度の伝送の場合には適している。

【0064】

(第4の実施例)

本発明による第4の実施例では樹脂を2段構成にして、面発光レーザの出射面と光ファイバ端面との距離を規定するものである。図7を用いてこれを説明する。

【0065】

光ファイバ16の芯線径よりも細い $150\mu\text{m}\phi$ の穴62を形成した感光性樹脂60を厚さ $100\mu\text{m}$ で1層目とし、光ファイバ16のクラッド74まで含んだ芯線が挿入できる $300\mu\text{m}\phi$ の光ファイバガイド穴63を厚さ $200\mu\text{m}$ で2層目の感光性樹脂61で形成している。これは、第1実施例と同様の樹脂パターンニング工程を2回繰り返すことで構成することができる。

【0066】

ここで、プラスチック光ファイバ16は、全フッ素化ポリマーからコア73およびクラッド74を構成したもので、アクリルからなる保護層（不図示）を削除した後、コア73およびクラッド74をまとめて、微小金属半球体からなる凸面に加熱押し付けして凹面先端部75としている。硬化性樹脂76は、全フッ素化ポリマーより屈折率の高い材料からなり、これをプラスチック光ファイバ16の凹面先端部75に滴下した後に光ファイバを光ファイバガイド穴63に挿入し、プラスチック光ファイバ16周辺の隙間をすべて硬化性樹脂76で埋め尽くす。

【0067】

上記2段構造の光ファイバガイド穴構造によって、光ファイバの凹面先端部75の周囲を感光性樹脂層60に突き当たるように実装する場合にも、発光または受光素子に衝突してダメージを与えることはない。また、光ファイバ先端の凹面部75に挿入された硬化性樹脂76が凸レンズとなり、直下の発光または受光素子と光結合が効率よく行われる。この方法では、凸レンズの焦点距離に応じて一層目の樹脂60の厚さを制御することができる。

【0068】

(第5の実施例)

図8に本発明の第5の実施例の厚膜レジスト70のパターンの平面図を示す。ファイバを実装するガイド穴72の他に溝71を形成している。

【0069】

この溝71を形成することで、厚膜レジスト70の現像時間を早める効果、下地とのストレスの緩和の効果、および固定用の接着剤の逃げとしての作用などがある。さらに、ファイバをガイド穴72に入れるときに嵌合しやすいという利点もある。

【0070】

厚膜レジストを用いてファイバガイド穴を形成する方法の場合、このようにホトマスクのパターンを変えることで自由にパターン形状を設計できる。たとえば、ファイバ径の異なるもの(1mmφ、500μmφ、250μmφなど)を集積化させたりすることもできる。

【0071】

(第6の実施例)

本発明による第6の実施例は、以上で述べてきた光実装体をモジュール化してできた高速光配線装置に関するものである。

【0072】

図10は、上記の実施例のような厚膜レジストによるガイド穴によって、面発光レーザや面型受光素子とファイバが固定された実装体を用いた光インタコネクションモジュールを示している。図10(a)において、94は4本のファイバを束ねたりボンファイバで、95はPOF（ここでは端面を平坦に描いてあるが上記の実施例の如く凹面或いは凸面になっている）、96はPOF固定用治具、93は全体をカバーしてPOF95の固定強度を強めるものである。また、92は図1で示した実装基板1であるが、周辺回路も同時に形成してチップ抵抗やコンデンサも集積化している。更に、90は接続用リード91を固定する台座であり、実装基板92の裏面と接着して、実装基板92の電極パッドとリード91のトップとをワイヤボンディングで接続している。ファイバ95と実装基板92との間の固定はワイヤボンディングを行ってから最後に行う。接続用リード91と実装基板92の接続は、実装基板92にスルーホールを形成してフリップチップ実装で行ってもよい。

【0073】

一方、図10(b)、(c)には、このコネクタモジュールと回路基板97との実装形態を示す。(b)において、基板97上に、ソケット98をリード102とはんだ10で固定しており、コネクタモジュールの接続リード91とソケット98の板ばね99とで接触が得られるようになっており、脱着可能である。(c)においては、接続リード91を、直接、回路基板97にはんだ付け(103)するものである。

【0074】

このような構成にすることで、高速信号の伝送をボード間で行う場合の光配線装置を提供することができる。1chあたり1Gbpsを越えるような場合や、電磁放射ノイズが問題になるような場合に有効となる。

【0075】

図10(c)では回路基板97に固定することになるが、実装基板92とファイバ固定

治具93との間を接着せず、厚膜レジスト100のガイド穴のところで脱着可能にしてもよい。その場合、ファイバ固定治具93の外枠にツメなどを設けて脱着可能な機械機構を形成すればよい。尚、101はカバーである。

【0076】

(第7の実施例)

本発明による第7の実施例は、第6の実施例のように光実装体の集積された光送受信モジュールを直接マザーボードに装着するのではなく、図11に示すように電気コネクタ110内に収めて、電気接続リード111を介してPCやモニタ、プリンタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどの電子機器のインターフェース部と脱着が可能のようにしている。この電気コネクタ110は必要な機器の規格に応じて作製することができる。例えば、PCと液晶モニタを接続するためのデジタルモニタインターフェースの規格に合わせて26ピンのMDRコネクタにしたり、IEEE1394やUSBなどの規格に合わせることも可能である。また、デジタル複写器のスクーナ部と感光部との内部接続などにも適用できる。これらの電子機器間の接続に本発明の光配線装置を用いることで、1チャンネルあたり1Gbpsから2.5Gbps程度で4～5チャンネルの信号伝送が50m以上可能となる。こうして、電気ケーブルでは限界のある高速映像伝送に代わって使用することができる。また、光接続であるので伝送線路から発生する電磁放射ノイズがなく、特に高速デジタル伝送でのノイズ対策の軽減につなげられる。

【0077】

【発明の効果】

本発明によって以下のような効果が期待される。

光ファイバと光素子のアライメント精度を向上させ、光ファイバの固定作業も容易にして、生産性を向上させることができる。また、面型光素子を薄膜化することで光ファイバとの光結合を別個のレンズ無しで行う際の実装の容易性、設計の自由度を向上させることができる。

【0078】

また、プラスチック光ファイバの光結合効率を高めるために先端レンズ加工を施した状態で、発光または受光素子との光実装を容易に行える。その際、光ファ

イバ素材と充填・接着用硬化性或いは非硬化性樹脂との屈折率の大小関係に応じて、先端を凹面もしくは凸面とすることで、結果として、凸レンズ作用をもたらすことができる。

【0079】

さらに、接続にともなう挿入損失を低減させ、その結果、低消費電力の光インタコネクションモジュールを提供できる。

【0080】

さらには、このような高効率な実装をするための構造体を量産できる作製方法を提供することで、低コスト化が可能な光実装体ないし光インタコネクションモジュールおよびこれを用いた光配線装置を実現できる。従って、高速デジタル信号を扱う電子機器内のボード間、あるいは電子機器同志の信号接続において、電気接続では限界のある領域、すなわち50m以上で2.5Gbps程度の信号伝送が可能となり、大容量の映像伝送などを容易に、特別な電磁ノイズ対策などもなしに行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による第1実施例の面型光素子実装体を説明する斜視図である。

【図2】

本発明による第1実施例における面型光素子実装体の断面図である。

【図3】

本発明による面型光素子の作製方法を説明する断面図である。

【図4】

本発明による面型光素子実装体の配線を説明する平面図である。

【図5】

本発明による面型光素子実装体の作製方法を説明する斜視図である。

【図6】

本発明による第3実施例の面型光素子実装体の断面図である。

【図7】

本発明による第4実施例の面型光素子実装体の断面図である。

【図8】

本発明による第4実施例のガイド穴形状の平面図である。

【図9】

本発明による第2実施例の面型光素子実装体を説明する斜視図である。

【図10】

本発明による光接続モジュールを説明する図である。

【図11】

本発明による光配線装置を示す斜視図である。

【図12】

第1の従来の面型光素子と光ファイバの結合を説明する断面図である。

【図13】

第2の従来の面型光素子と光ファイバの結合を説明する断面図である。

【図14】

第3の従来の面型光素子と光ファイバの結合を説明する図である。

【符号の説明】

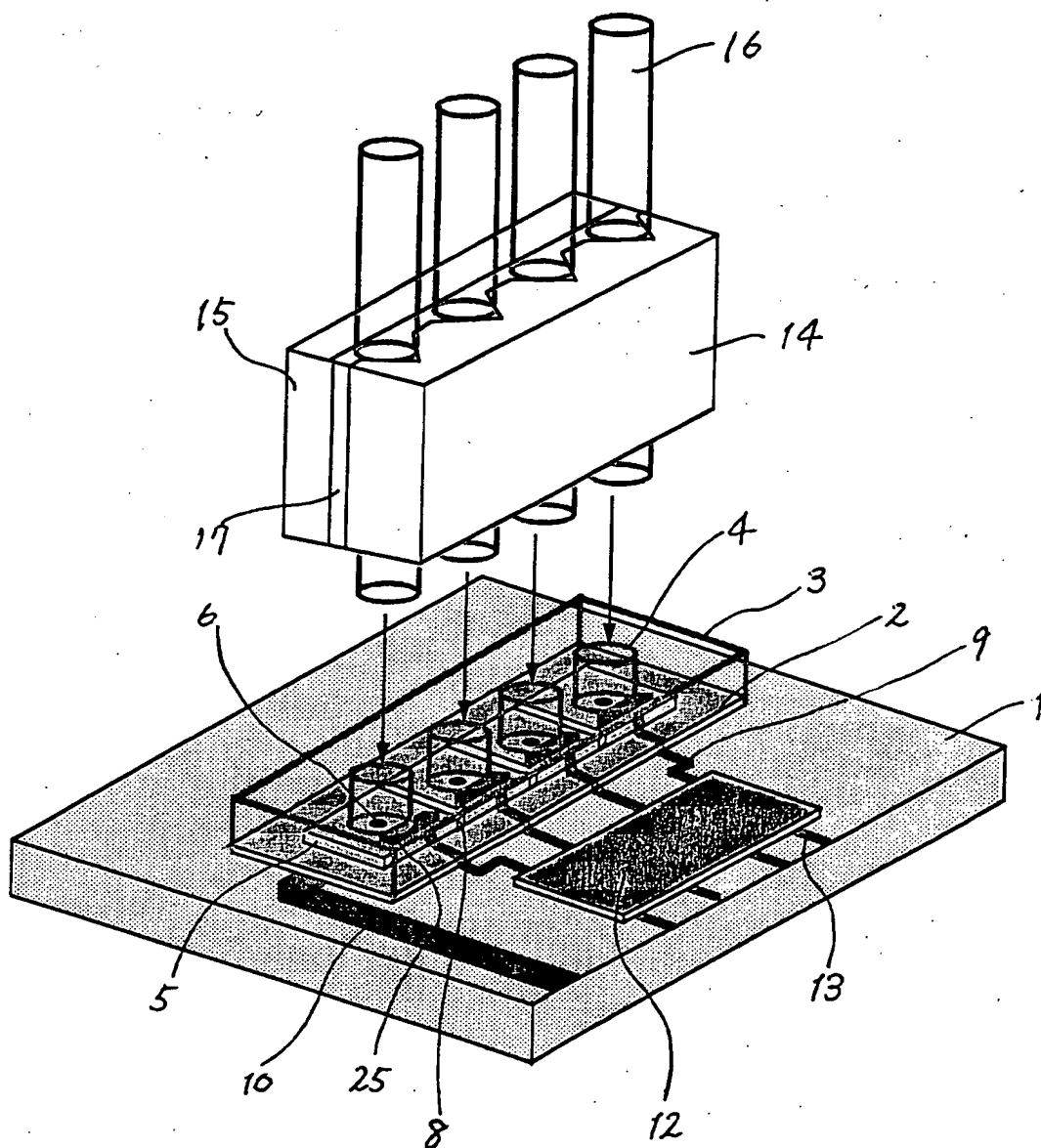
- 1…実装基板
- 2,80…電極パッド
- 3,60,61,70,100…厚膜レジスト
- 4,63,72,1209…ファイバガイド穴
- 5,84…面型光素子
- 6,31,62,83…光透過窓
- 8…素子分離溝
- 9,10,13…電気配線
- 12,53…Si-IC
- 14,15,2014…ファイバ固定治具
- 16,64,95,1037,1210,2016…光ファイバ
- 17,1211…接着剤
- 18,75…凹面先端部
- 19,76…硬化性樹脂

20,25,1033,1035…電極
21,26,1208…絶縁膜
22,24,1023,1027…DBRミラー
23…活性層および共振器層
27…埋め込み層
28…エアポスト
29…選択酸化 Al_2O_3 層
30,1021…基板
32…コンタクトホール
50…レーザウエハ
51…レーザチップ
52…実装用ウエハ
54…実装領域
55…ダイシングする切り取り線
65…凸面先端部
71…溝
73…コア
74…クラッド
90…接続リード固定用台座
91,111…接続リード
92…光実装体
93,96…ファイバ固定治具
94…ファイバアレイ
97…回路基板
98…ソケット
99…板ばね
101…カバー
102…接続ピン
103…はんだ

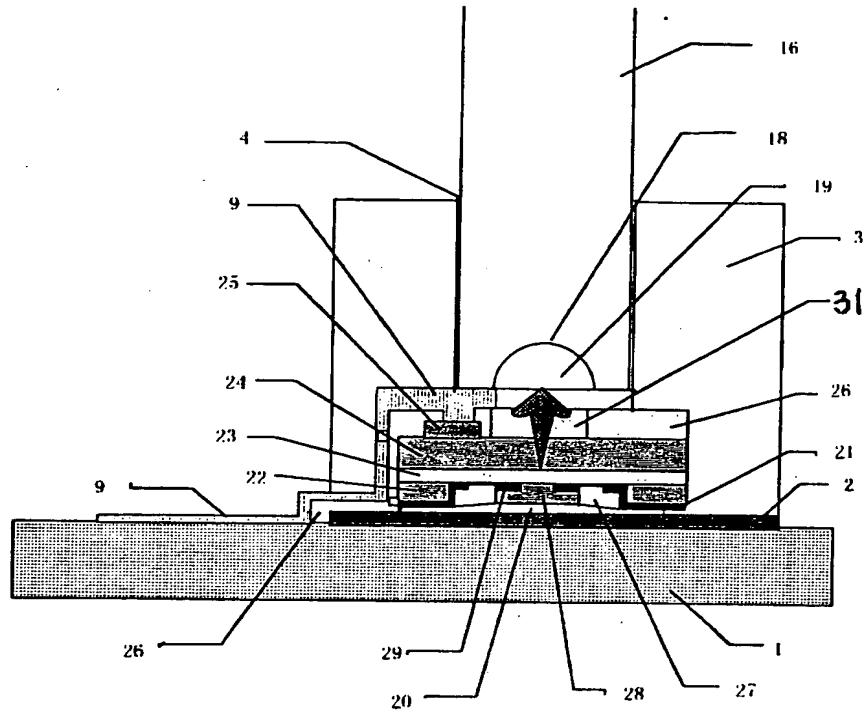
110…電気コネクタ
1022…光吸収層
1024,1026…クラッド層
1025…活性層
1028…コンタクト層
1032…SiO₂
1036…反射防止膜
1201…電子回路基板
1202…発光チップ
1203,2018…面発光レーザ
1204…トランジスタ
1205,1206,1207…トランジスタ電極
2012…モジュール基板
2022,2023…突起
2024…ファイバ挿入孔
2026,2027…ガイド孔

【書類名】 図面

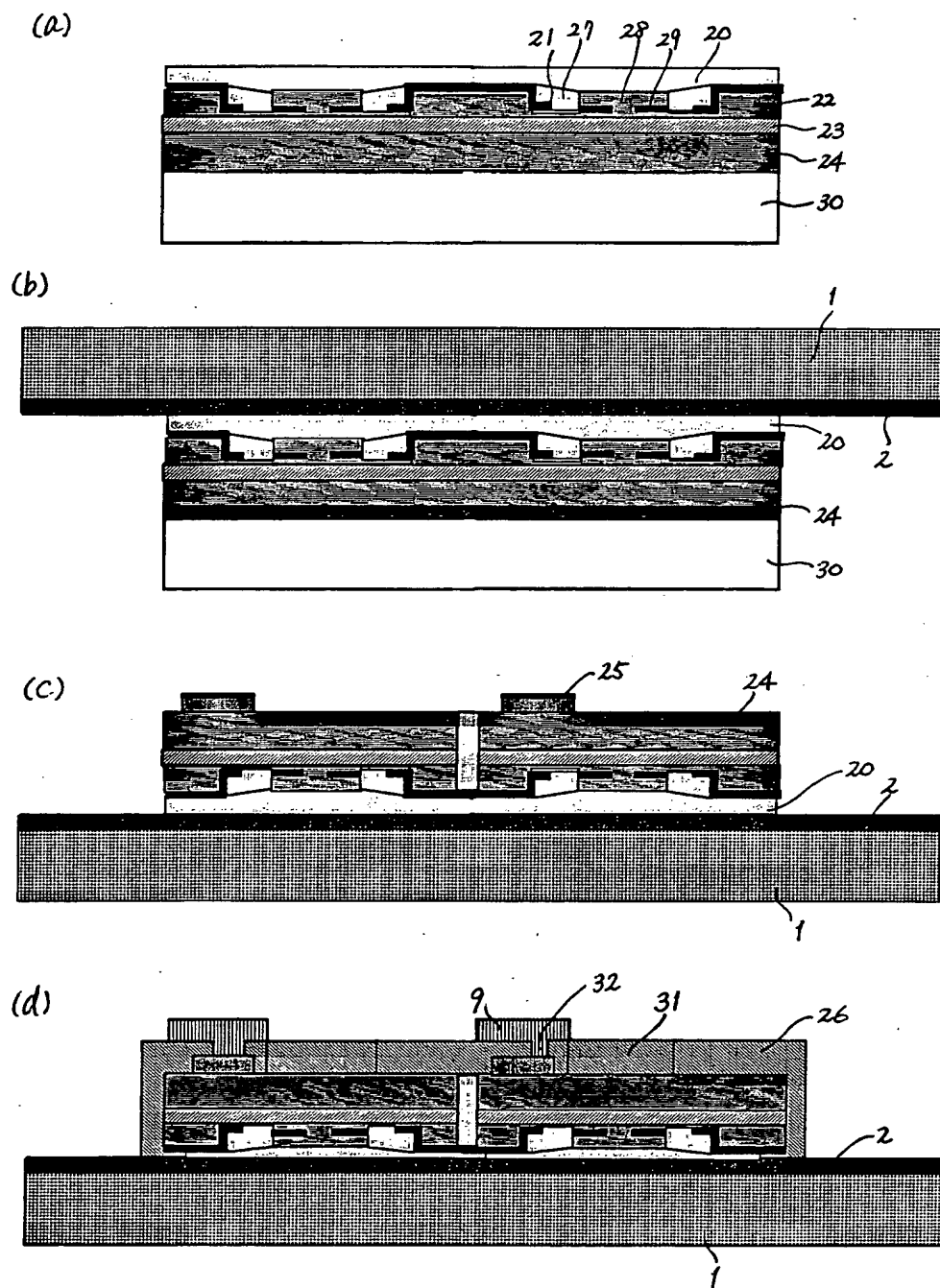
【図1】



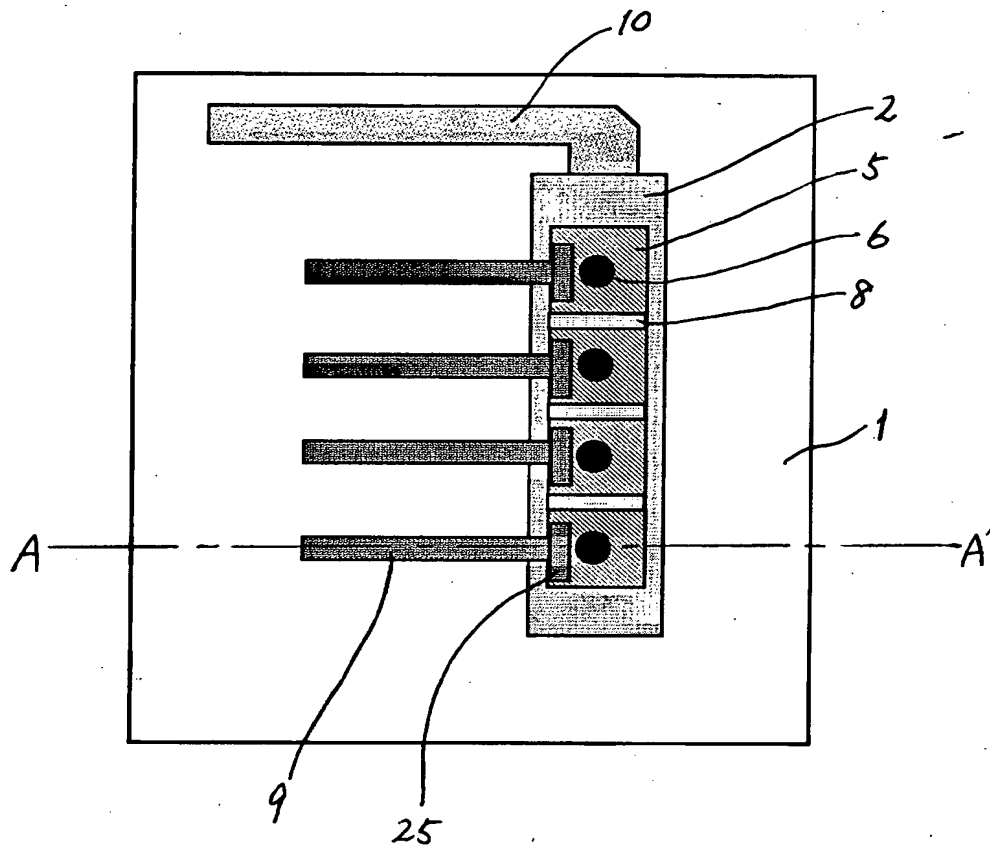
【図2】



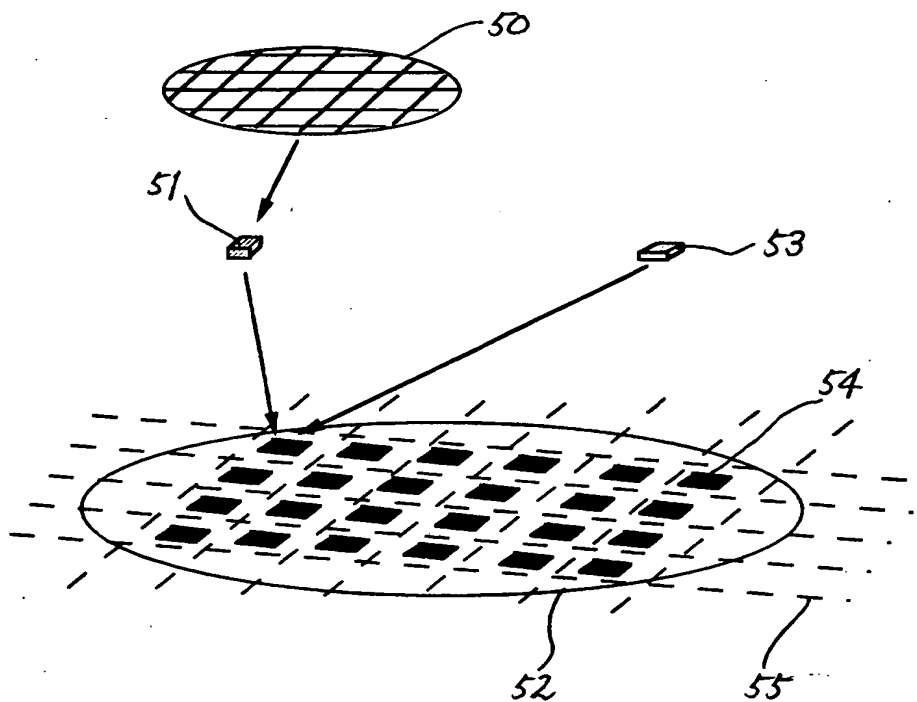
【図3】



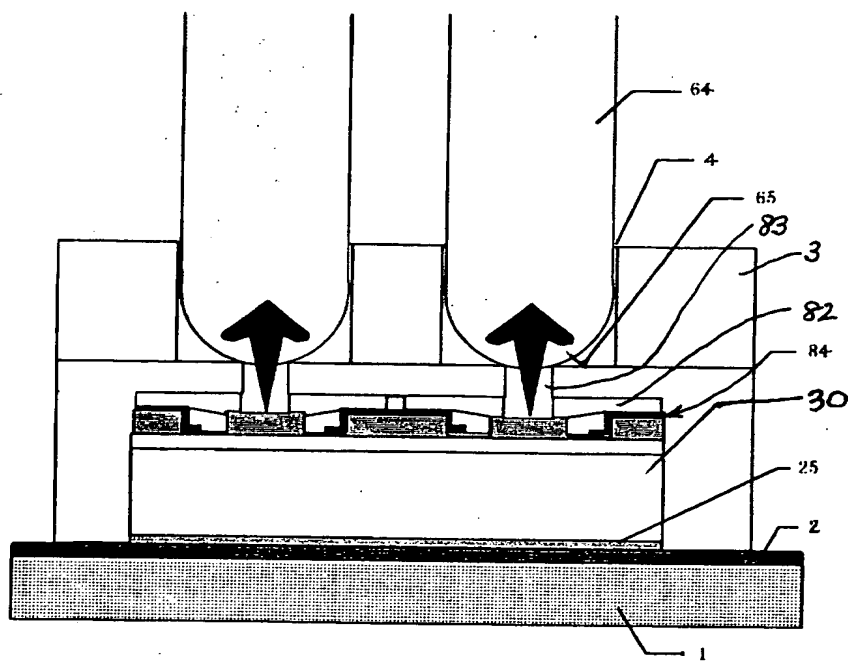
【図4】



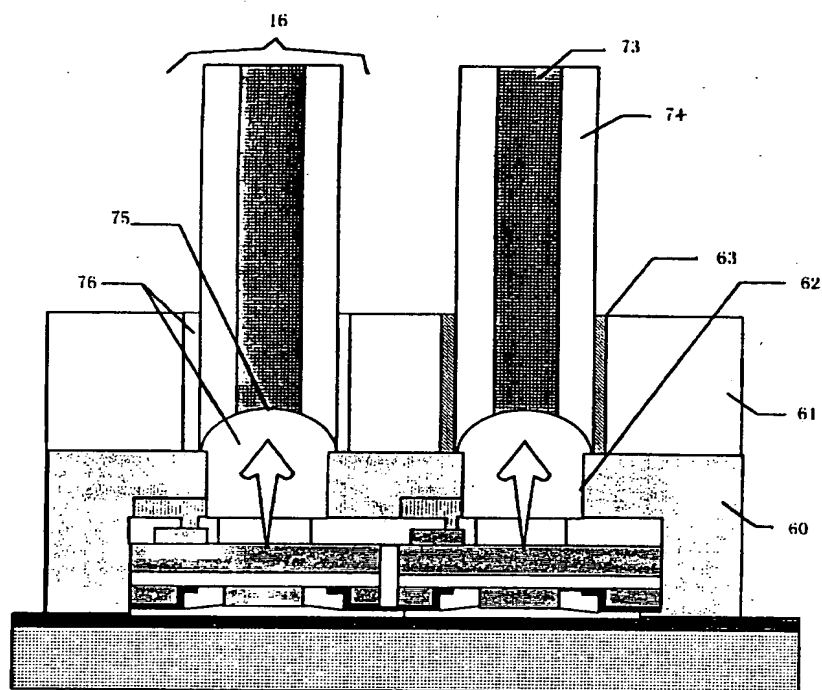
【図5】



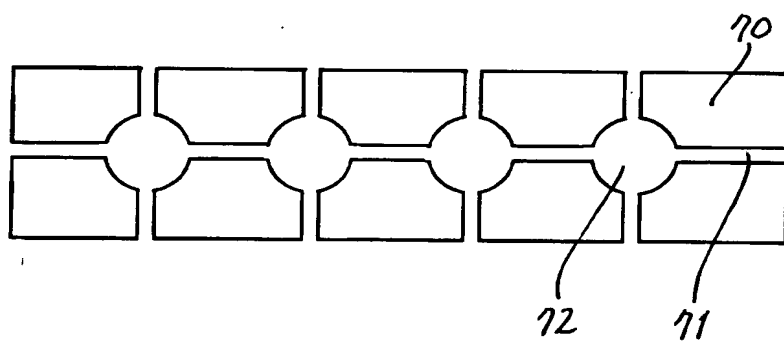
【図6】



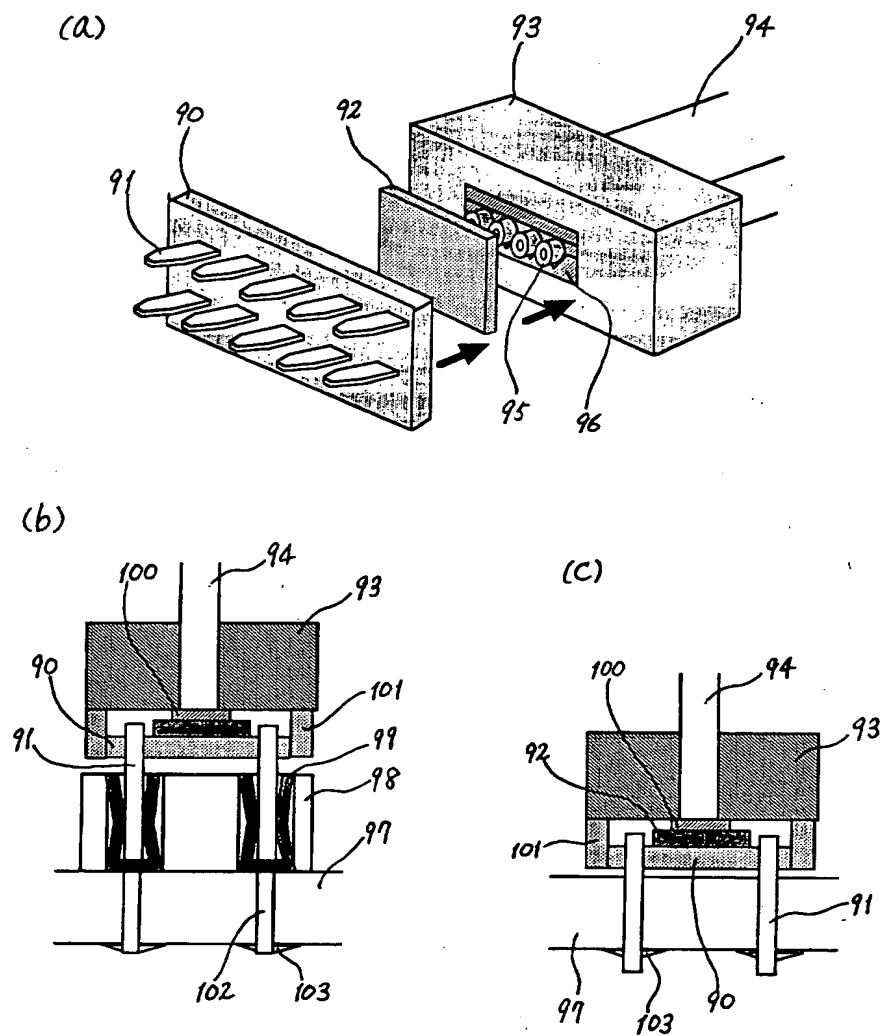
【図7】



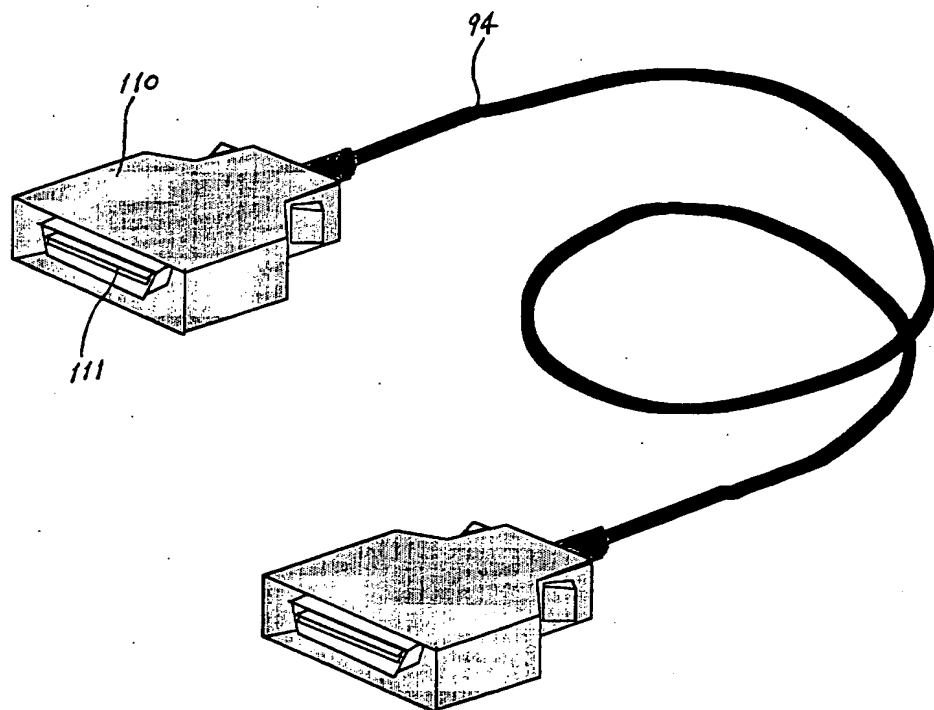
【図8】



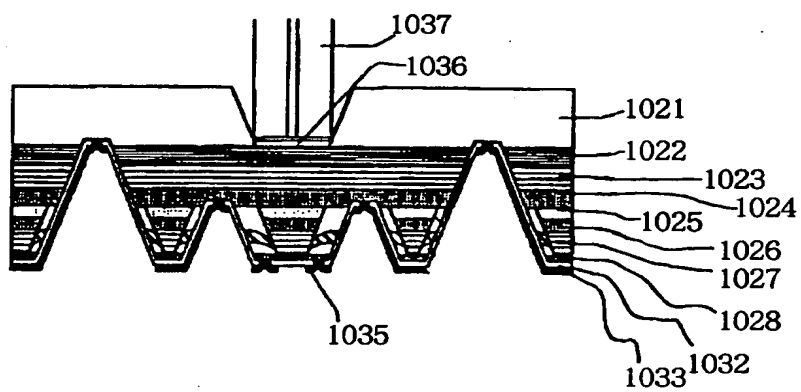
【図10】



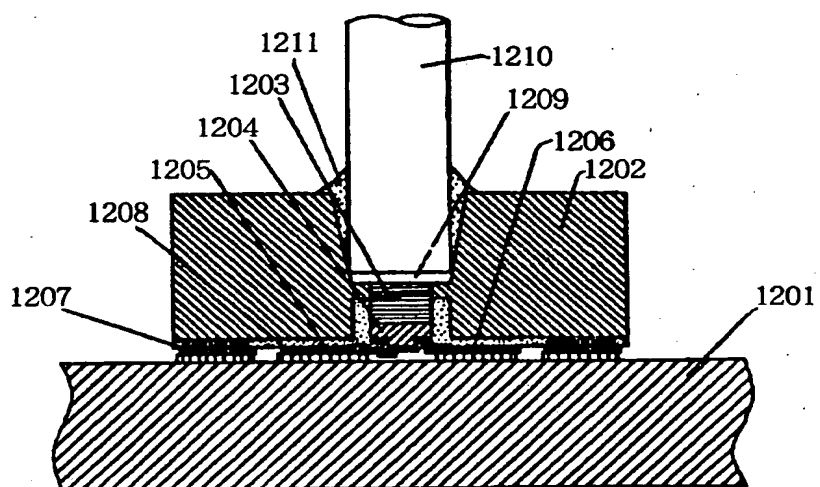
【図11】



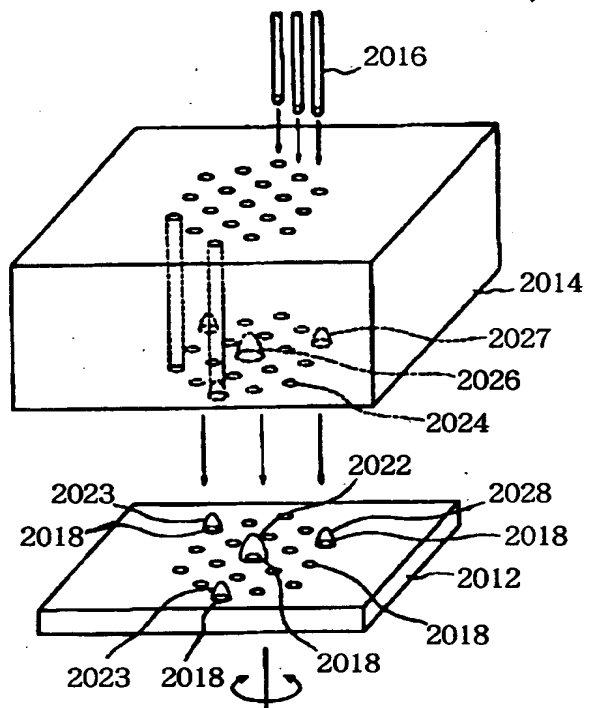
【図12】



【図13】



【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 部品点数の増加やプロセス制御性の向上を必要とせずに、プラスチック光ファイバと面型光素子のアライメント精度を向上させ、プラスチック光ファイバの固定作業も容易にして生産性を向上させ、低コスト化を図る面型光素子である。

【解決手段】 面型光素子5の表面に、面型光素子5との光結合が可能なようにプラスチック光ファイバ16を差し込んで固定するためのガイド穴4が形成される。ガイド穴4は、光感光性あるいは電子ビーム硬化性を持ちホトリソグラフィでパターンニングすることで選択的に硬化が可能な厚膜材料3で形成してある。プラスチック光ファイバ16の先端面はレンズ形状に加工して光結合効率を向上させている。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 3 0 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名	キャノン株式会社